2SD1637 エピタキシャルプレーナ形 NPN シリコンダーリントントランジスタ

低周波電力増幅用/Low Freq. Power Amp.

Epitaxial Planar NPN Silicon Darlington Transistor

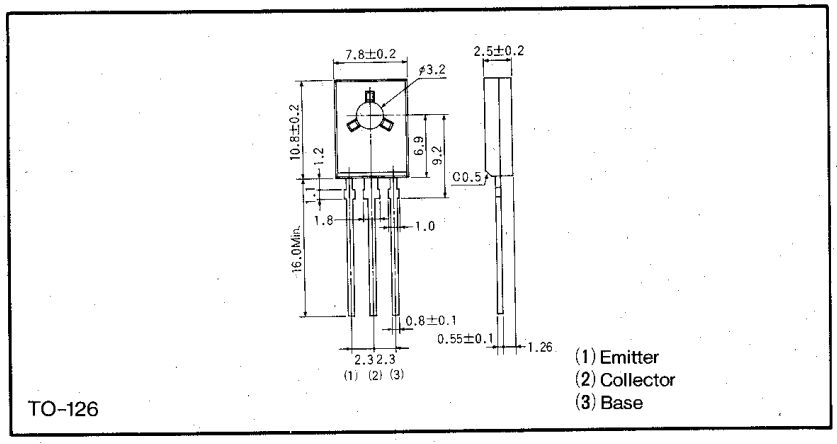
● 特長

1) コレクタ・ベース間に60Vのツェナーダイオードを内蔵。
2) サージに強い。
3) ダンパーダイオード内蔵。
4) ベース・エミッタ間に抵抗内蔵。

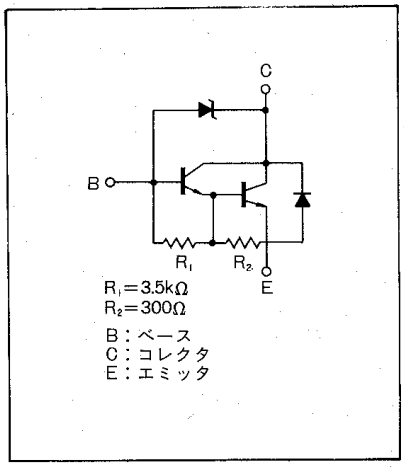
● Features

1) Zener diode of 60V is incorporated across collector and base.
2) Resistant to surge.
3) Damper diode is incorporated.
4) Built-in resistance across base and emitter.

● 外形寸法図／Dimensions (Unit : mm)



● 内部等価回路図



● 絶対最大定格／Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	60±10	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	60±10	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	6	V
コレクタ電流	I_C	2	A
		3	A(Pulse)
コレクタ損失	P_C	15	W(Tc=25℃)
		1.2	W(Ta=25℃)
接合部温度	T_j	150	℃
保存温度範囲	T_{stg}	−55～150	℃

● 電気的特性／Electrical Characteristics (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CEO}	50	—	70	V	I_C=5mA
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CBO}	50	—	70	V	I_C=50μA
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	—	—	10	μA	V_{CB}=40V
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	—	—	3	mA	V_{EB}=5V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	—	1.5	V	I_C/I_B=1A/1mA
直流電流増幅率	h_{FE}	1 000	—	10 000	—	V_{CE}/I_C=2V/1A
出力容量	C_{ob}	—	25	—	pF	V_{CB}=10V, I_E=0A, f=1MHz

● 標準品・準標準品一覧表 (◎：標準品 ○：準標準品)

Type	h_{FE}	包装名	バルク
		記　号	
		基本発注単位(個)	1 000
2SD1637	1K～10K		○